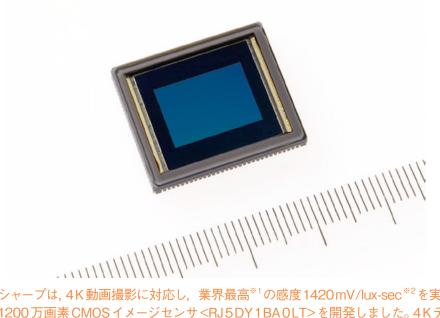
# 4K対応1型1200万画素 CMOSイメージセンサ



## 開発者より



電子デバイス事業本部 センシングデバイス事業部 第5開発部 (後列左から) 由井達哉 荒川友章 松岡伸明 (前列左から) 森川佳直 浦田卓治

CMOSセンサは画質という点で、ファンクション動作とは別の難しさがあり、他半導体カテゴリーとの違いに、やりがいや面白さを感じています。 開発に当っては、市場のニーズにマッチしたファンクションと、タイミングをミートさせてデビューさせる事の両方が重要であり、チーム力、突破力、前進力を向上させて、今後も取り組んでいきます。

シャープは、4K動画撮影に対応し、業界最高 $^{*1}$ の感度  $1420\,\mathrm{mV/lux-sec}^{*2}$  を実現したデジタルビデオカメラ向け1型  $1200\,\mathrm{万画素}$  CMOS イメージセンサ <RJ5DY1BA0LT> を開発しました。4K テレビは、世界的な放送インフラ環境の整備とともに、普及拡大が見込まれています。本市場の立ち上りに伴い、デジタルビデオカメラなどの周辺機器においても4K 対応への期待が高まっています。本イメージセンサは、1型の光学サイズで4K 動画撮影に適した $3.1\,\mu\,\mathrm{m}$  角の大型画素セルを採用。独自の画素セル技術を活用することで、業界最高感度  $1420\,\mathrm{mV/lux-sec}$  と高色再現性を実現しました。明るいシーンはもとより暗いシーンでも鮮明な画像の撮影に貢献します。また、画素信号の読み出しの高速化と、少ない電力でデジタル変換する独自の回路技術を搭載。4K 動画を $60\,\mathrm{fps}$   $*^3$  で撮影する際に、業界トップレベルの低消費電力 $420\,\mathrm{mW}$  を実現しました。低消費電力化によりイメージセンサの発熱を抑制できるため、搭載機器の放熱設計の簡略化に貢献するとともに、熱によるノイズの少ない高画質撮影を可能にします。さらに、 $1200\,\mathrm{T}$  画素の静止画撮影にも対応し、デジタルスチルカメラ用途としても活用いただけます。

- ※1 2014年8月20日現在。1型4K対応のCMOSイメージセンサにおいて。シャープ調べ。
- ※2 色温度3200Kの光源, F5.6の光学系を用いて撮影した時のG信号の平均出力。
- ※3 60 frames per secondの略。1秒あたり60枚の静止画で構成される動画。

### 3.1µm角の大型画素セルと独自の 画素セル技術を活かし、業界最高感度 1420mV/lux-secと高色再現性を実現

1型光学サイズで4Kの動画撮影,および1200万画素の静止画撮影の両方に対応した大型画素セルサイズ3.1μm角を採用。さらに、よりたくさんの光を集める独自の高集光・高開口画素セル設計技術、取り込んだ光を無駄なく電気信号に変換する高効率フォトダイオード形成技術などにより、業界最高感度1420mV/lux-secと高色再現性を実現しました。明るいシーンはもとより、暗いシーンでも鮮明な画像の撮影に貢献します(図1)(図2)。

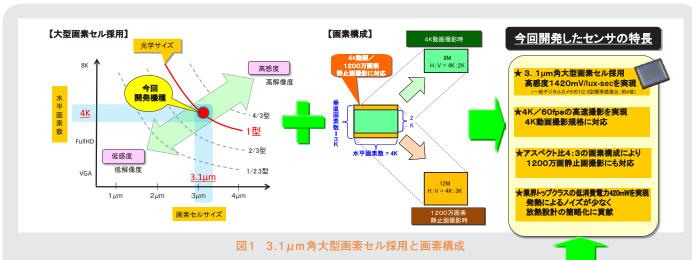
# 4K/60fpsの動画撮影に対応し、業界トップレベルの低消費電力420mWを実現。 発熱によるノイズの少ない高画質撮影に貢献

一般的に撮影した画像信号は、1ライン毎に読み出しますが、本センサは、独自の2ライン同時読み出し方式を採用しており、4K動画撮影において、60fpsの高速撮影に対応しました(フルHD/120fpsにも対応)。また、高速読み出しと低消費電力化はトレードオフの関係にありますが、当社独自のアナログ電力半減回路技術の開発により、業界トップレベルの低消費電力420mWを実現しました。一方、イメージセンサは、高温になるほど暗電流増大に

より、ノイズが発生しやすくなり、画質の劣化を招きますが、低消費電力化により発熱を抑制しました。これにより、デジタルビデオカメラなど搭載機器の放熱設計の簡略化、小型化に寄与するとともに、高画質撮影に貢献します(図3)(図4)。

#### 静止画撮影にも対応し, デジタル スチルカメラ用途でも活用

4K動画撮影に加え,1200万画素(アスペクト比4:3)の静止画撮影にも対応しています。



### 高感度 (A) 高集光技術・・・・光学シミュレーションにより最適化したレンズ形状(B) 高開口技術・・配線レイアウト及び配線層厚みの削減(C) フォトダイオード形成技術・・・深く形成し光電変換効率向上 入射光 (A) オンチップレンズ \*\*\*\*\* ----□ 配線層(厚みを削減) **## 33 33** フォトダイオードを 深く形成 従来品の深さ位置 Pウェル (D) N-sub基板 高色再現性 (D) N-sub基板を採用により、過剰電荷が他色の画素へ漏れ込み(混色)を 抑制でき、色再現性を向上

高速読み出し (A) 共通の画素読出信号線を時分割使用して, 2ライン分の同時画素 (A) 大通の国来が出当っている。 読み出しにより、4K/60fpsを実現 (B) 当社独自高速セトリング技術にて画素読出時間を50%短縮(※1) 列AD変換器(奇数ライン) 画素読み出し 画素読み出し 画素読み出し (奇数ライン) 画素読み出し 画素エリア (奇数ライン) 2ライン分の水平期間 奇数ライン 偶数ライン Gt B R Gr 高速セトリング技術 画素読み出し信号 列AD変換器(偶数ライン) シグナルサンプリング

図3 高速読み出し技術

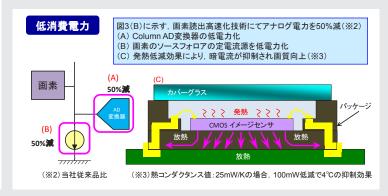


図2 画素セル技術

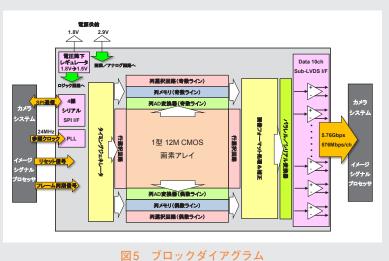


図4 電力低減技術による発熱の抑制

形名	RJ5DY1BA0LT
光学サイズ	1型
総 画 素 数	1311万画素
撮像画素数	1282万画素
画素サイズ	$3.1 \mu \text{m} \times 3.1 \mu \text{m}$
感 度 (typ.)	1420mV/lux-sec
動 画 対 応	4K2K/60fps
消費電力	420mW(4K2K/60fps撮影時)

主な仕様

本記事は2014年9月に当社ホームページに掲載したものです。